

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2002-367230

(43)Date of publication of application : 20.12.2002

(51)Int.Cl.

G11B 7/24
G11B 7/004

(21)Application number : 2001-170584

(71)Applicant : MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing : 06.06.2001

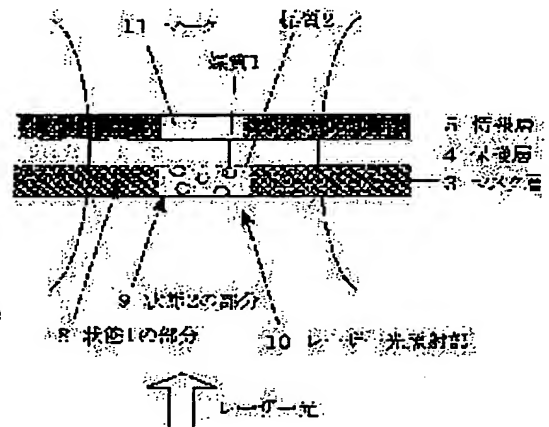
(72)Inventor : UNO MAYUMI
SHIONO TERUHIRO
YAMAMOTO HIROAKI

(54) OPTICAL INFORMATION RECORDING MEDIUM AND RECORDING AND REPRODUCING DEVICE FOR THE SAME AS WELL AS RECORDING AND REPRODUCING METHOD FOR THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To sufficiently obtain the intensity of recording and reproducing signals in performing recording and reproducing at an super-high resolution.

SOLUTION: This optical information recording medium has at least a mask layer and an information layer on a substrate. Portions of the parts irradiated with a laser beam of the mask layer are temporarily changed from a state 1 to a state 2 optically different therefrom when irradiated with the laser beam. The mask layer existing in the state 2 forms the boundary intensified in the generation of a surface plasmon, thereby making it possible to enhance the signal intensity in recording and reproducing the recording bits smaller than the resolution threshold. As a result, the recording medium which makes the higher density recording possible and the recording and reproducing method for the same can be provided.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-367230

(P2002-367230A)

(43)公開日 平成14年12月20日 (2002. 12. 20)

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テームト* (参考)
G 1 1 B 7/24	5 3 8	G 1 1 B 7/24	5 3 8 A 5 D 0 2 9
	5 1 6		5 1 6 5 D 0 9 0
	5 3 5		5 3 5 C
7/004		7/004	Z

審査請求 未請求 請求項の数16 O L (全 11 頁)

(21)出願番号 特願2001-170584(P2001-170584)

(22)出願日 平成13年6月6日(2001. 6. 6)

(71)出願人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 宇野 真由美

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

(72)発明者 塩野 照弘

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

(74)代理人 100097445

弁理士 岩橋 文雄 (外2名)

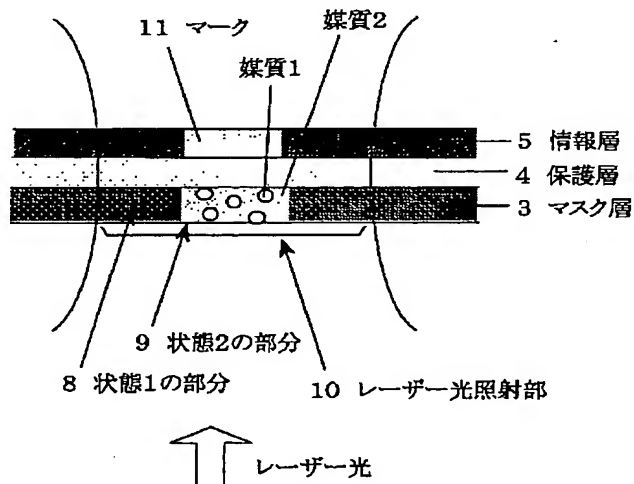
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 光学情報記録媒体とその記録再生装置、及びその記録再生方法

(57)【要約】

【課題】 超解像での記録再生を行う際に、記録再生信号の強度が十分に得られなかった。

【解決手段】 基板上にマスク層と情報層とを少なくとも有し、マスク層は、レーザー光の照射時にレーザー光照射部の一部分が、状態1から光学的に異なる状態2へと一時的に変化し、状態2のとき表面プラズモンの発生が増強される界面を形成することによって、解像限界より小さい記録ピットを記録再生する際の信号強度を増大させることが可能となる。これにより、さらなる高密度記録が可能な記録媒体とその記録再生方法を提供することができる。



BEST AVAILABLE COPY

【特許請求の範囲】

【請求項1】基板上にマスク層と情報層とを少なくとも有し、前記マスク層は、レーザー光の照射時に前記レーザー光の照射部の一部分が、状態1から光学的に異なる状態2へと変化するることによって、前記レーザー光の波長を λ 、開口数をNAとすると、前記情報層に形成された $\lambda/(4 \times NA)$ よりも小さい記録ピットを読み出すことが可能であり、

前記マスク層が前記状態2のとき、マスク層の表面或いは内部に異なる媒質が接する界面が存在し、前記の異なる媒質をそれぞれ媒質1、媒質2とし、前記レーザー光の波長における媒質1の複素屈折率を $n_1 - ik_1$ 、媒質2の複素屈折率を $n_2 - ik_2$ とすると、 $(-5.0) \times n_2^2 \leq n_1^2 - k_1^2 \leq (-1.0) \times n_2^2$ の関係を満たすことを特徴とする光学情報記録媒体。

【請求項2】マスク層がAu、Ag、或いはCuのうち少なくとも1元素を含むことを特徴とする請求項1記載の光学情報記録媒体。

【請求項3】マスク層がAgを含み、かつ情報の読み出しに用いるレーザー光の波長が200nmから580nmの範囲内にあることを特徴とする請求項1記載の光学情報記録媒体。

【請求項4】マスク層がAuTe、CuTe、SnTe、NiCr、Crのうち少なくともいずれか1つを含むことを特徴とする請求項1記載の光学情報記録媒体。

【請求項5】マスク層がSn-O、In-O、Zn-Oのうち少なくともいずれか1つを含むことを特徴とする請求項1記載の光学情報記録媒体。

【請求項6】マスク層が少なくとも1種類の希土類元素を含むことを特徴とする請求項1記載の光学情報記録媒体。

【請求項7】マスク層が異なる2つの状態を変化しうる転移温度が130℃以上400℃以下であることを特徴とする請求項1記載の光学情報記録媒体。

【請求項8】情報層が2つ以上の光学的に異なる状態間を変化しうる材料よりなることを特徴とする請求項1記載の光学情報記録媒体。

【請求項9】情報層が結晶状態とアモルファス状態とを可逆的に変化しうる材料よりなることを特徴とする請求項8記載の光学情報記録媒体。

【請求項10】情報層が作製直後で結晶状態であることを特徴とする請求項9記載の光学情報記録媒体。

【請求項11】情報層がSb、Te、Seのうち少なくともいずれか1つを含む相変材料であることを特徴とする請求項9記載の光学情報記録媒体。

【請求項12】情報層が1回のみ書き込みが可能である材料よりなることを特徴とする請求項8記載の光学情報記録媒体。

【請求項13】情報層がTeとOとを少なくとも含む材料よりなることを特徴とする請求項12記載の光学情報

記録媒体。

【請求項14】基板上にマスク層と情報層とを少なくとも有し、前記マスク層は、レーザー光の照射時に前記レーザー光の照射部の一部分が、状態1から光学的に異なる状態2へと変化するることによって、前記レーザー光の波長を λ 、開口数をNAとすると、前記情報層に形成された $\lambda/(4 \times NA)$ よりも小さい記録ピットを読み出すことが可能であり、

前記マスク層が前記状態2のとき、マスク層の表面或いは内部に異なる媒質が接する界面が存在し、前記の異なる媒質をそれぞれ媒質1、媒質2とし、媒質1の波長 λ における複素屈折率を $n_1 - ik_1$ 、媒質2の波長 λ における複素屈折率を $n_2 - ik_2$ とすると、 $(-5.0) \times n_2^2 \leq n_1^2 - k_1^2 \leq (-1.0) \times n_2^2$ の関係を満たす光学情報記録媒体を用い、波長 λ のレーザー光を用いて情報の記録再生を行うことを特徴とする光学情報記録媒体の記録再生装置。

【請求項15】基板上にマスク層と情報層とを少なくとも有し、前記マスク層は、レーザー光の照射時に前記レーザー光の照射部の一部分が、状態1から光学的に異なる状態2へと変化するることによって、前記レーザー光の波長を λ 、開口数をNAとすると、前記情報層に形成された $\lambda/(4 \times NA)$ よりも小さい記録ピットを読み出すことが可能であり、

前記マスク層が前記状態2のとき、マスク層の表面或いは内部に異なる媒質が接する界面が存在し、前記の異なる媒質をそれぞれ媒質1、媒質2とし、媒質1の波長 λ における複素屈折率を $n_1 - ik_1$ 、媒質2の波長 λ における複素屈折率を $n_2 - ik_2$ とすると、 $(-5.0) \times n_2^2 \leq n_1^2 - k_1^2 \leq (-1.0) \times n_2^2$ の関係を満たす光学情報記録媒体を用い、波長 λ のレーザー光を用いて情報の記録再生を行うことを特徴とする光学情報記録媒体の記録再生方法。

【請求項16】基板上にマスク層と情報層とを少なくとも有する光学情報記録媒体を用いて情報の記録再生を行う装置であり、前記マスク層は、レーザー光の照射時に前記レーザー光の照射部の一部分が、状態1から光学的に異なる状態2へと変化するることによって、前記レーザー光の波長を λ 、開口数をNAとすると、前記情報層に形成された $\lambda/(4 \times NA)$ よりも小さい記録ピットを読み出すことが可能であり、かつ前記マスク層が前記状態2のとき、マスク層の表面或いは内部に異なる媒質が接する界面が存在し、この界面において表面プラズモンが存在しうる条件とすることによって、情報信号の再生信号強度を向上させることを特徴とする光学情報記録媒体の記録再生装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、レーザー光線の照射等の光学的な手段を用い、高密度、高速度での情報の

記録再生が可能で、特に十分な信号強度を得ることが出来る光学情報記録媒体及び記録再生装置、及び記録再生方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】大容量、高速度での情報の記録再生が可能な媒体として、光磁気記録媒体や相変化形記録媒体等の光学情報記録媒体が知られている。これらの光学情報記録媒体は、必要に応じてランダムアクセスが可能であり、かつ可搬性にも優れるという大きな利点を有しているため、高度情報化社会においてますますその重要性が高まっている。例えばコンピュータを通じた個人データや映像情報等の記録、保存や、医療分野、学術分野、或いは家庭用ビデオテープレコーダーの置き換え等、様々な分野での需要が高まっている。現在、これらの光学情報記録媒体について、アプリケーションの高性能化や画像情報の高性能化に伴い、さらに大容量化（高密度化）、高速化を達成することが求められている。

【0003】さらなる高密度化を達成する手段として、レーザー光の集光スポット径を小さくする試みがなされている。集光スポットの大きさは、レーザー光の波長を λ 、レンズの開口数を NA とすると、 λ/NA に比例するため、レーザーの短波長化、或いは照射レーザービームの高 NA 化が従来より提案されている。

【0004】或いは高密度化を達成する別の手段として、集光スポット径よりも小さい記録マークを読み出すことを可能とする、いわゆる超解像記録技術が従来より提案されている。例えば、特開 2000-348377 号公報には、近接場光を用いた高密度化の技術が開示されている。この発明においては、光ディスクは基板上に保護層、マスク層、保護層、記録層、及び保護層がこの順に作製され、保護層は $ZnS-SiO_2$ 、記録層は相変化材料、マスク層は熱により酸素と銀に分解する酸化銀を使用している。光ディスクに収束光を照射すると、マスク層にレーザスポットが形成され、一定の閾値を越えた高温部で酸化銀が酸素と銀に分解し、屈折率が変化する。これによりマスク層にスポット径よりも小さな、屈折率変化領域としてのアパーチャが形成される。このアパーチャで発生したエバネッセント場により記録層に記録マークを書き込み、またこの記録マークを読み出すことができるというものである。この発明においては、マスク層で生じたエバネッセント場が到達可能な位置に記録層を設けることによって、高速書き込み、及び高速読みだしが可能となる技術が開示されている。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】しかし従来開示されている技術では、いわゆる超解像技術を用いて信号の再生を行う場合、記録信号がレーザーのスポット径よりも小さいために、再生信号強度が非常に小さくなってしまいうという課題がある。また、同様に超解像技術を用いて信号の記録を行う際にも、記録した信号の変調度が非常に

小さく、再生信号の強度が十分に得られないという課題がある。

【0006】またこれらの課題を解決するために、記録再生信号の強度を向上させようとして記録再生光強度を強めた場合、既にかき込まれた信号に熱的影響を与え、その信号を変質させてしまうという、いわゆる再生光劣化が生じるといった新たな課題が生じる。

【0007】本発明は上記課題を解決し、超解像記録再生において非常に小さいマークを記録再生する際であっても、十分な信号強度を得ることができる技術を提案するものである。また、信号の記録再生時において、既にかき込まれた信号に影響を与えることなく記録再生が可能な技術を提案するものである。これにより、さらなる高密度化が達成できる情報記録媒体を提供することが可能になる。

【0008】

【課題を解決するための手段】本発明に係る光学情報記録媒体は、基板上にマスク層と情報層とを少なくとも有し、マスク層は、レーザー光の照射時にレーザー光の照射部の一部分が、状態 1 から光学的に異なる状態 2 へと変化することによって、前記レーザー光の波長を λ 、開口数を NA とすると、情報層に形成された $\lambda/(4 \times NA)$ よりも小さい記録ピットを読み出すことが可能であり、マスク層が状態 2 のとき、マスク層の表面或いは内部に異なる媒質 1、及び媒質 2 が接する界面が存在し、レーザー光の波長における媒質 1 の複素屈折率を $m_1 - i k_1$ 、媒質 2 の複素屈折率を $m_2 - i k_2$ とするとき、 $(-5.0) \times n_2^2 \leq m_1^2 - k_1^2 \leq (-1.0) \times n_2^2$ の関係を満たすものである。これにより、光学系の解像限界より小さい信号を記録再生する際であっても、信号強度が飛躍的に向上した光学情報記録媒体を得ることが可能になる。

【0009】情報層は 2 つ以上の光学的に異なる状態間を変化しうる材料よりなることが好ましい。これにより情報の記録、或いは書き換えが可能となるため、ユーザー情報の書き込みが可能である高密度記録媒体を提供することができる。マスク層が異なる 2 つの状態を変化しうる転移温度は 130°C 以上 400°C 以下であることが好ましい。これにより、既にかき込まれた信号を再生する際の再生光劣化を低減することが容易に可能となる。

【0010】本発明に係る光学情報記録媒体は、マスク層は Au、Ag、或いは Cu のうち少なくとも 1 元素を含むものである。上記の媒質 1、媒質 2 が満たすべき条件を容易に満たすことが可能となる。

【0011】本発明に係る光学情報記録媒体は、マスク層が Ag を含み、かつ情報の読み出しに用いるレーザー光の波長を 200nm から 580nm の範囲内とするものである。この好ましい例によれば、上記の媒質 1、媒質 2 が満たすべき条件を容易に満たすことができるばかりでなく、信号強度の増強をより顕著に得ることが可能となる。

【0012】本発明に係る光学情報記録媒体は、マスク層がAuTe、CuTe、SnTe、NiCr、Crのうち少なくともいずれか1つを含むものである。或いは、本発明に係る光学情報記録媒体は、マスク層がSn-O、In-O、Zn-Oのうち少なくともいずれか1つを含むものである。或いは、本発明に係る光学情報記録媒体は、マスク層は少なくとも1種類の希土類を含むものである。この場合においても、信号強度の増強をより顕著に得ることが可能となる。

【0013】本発明に係る光学情報記録媒体は、マスク層が異なる2つの状態を変化しうる転移温度が130℃以上400℃以下であることを特徴とする。

【0014】本発明に係る光学情報記録媒体は、情報層が2つ以上の光学的に異なる状態間を変化しうる材料よりなることを特徴とする。

【0015】本発明に係る光学情報記録媒体は、情報層が結晶状態とアモルファス状態とを可逆的に変化しうる材料よりなることを特徴とする。

【0016】本発明に係る光学情報記録媒体は、情報層が作製直後で結晶状態であることを特徴とする。

【0017】本発明に係る光学情報記録媒体は、情報層がSb、Te、Seのうち少なくともいずれか1つを含む相変化材料であることを特徴とする。

【0018】本発明に係る光学情報記録媒体は、情報層が1回のみの書き込みが可能である材料よりなることを特徴とする。

【0019】本発明に係る光学情報記録媒体は、情報層がTeとOとを少なくとも含む材料よりなることを特徴とする。

【0020】本発明に係る光学情報記録媒体の記録再生装置は、基板上にマスク層と情報層とを少なくとも有する光学情報記録媒体を用いて情報の記録再生を行う装置であり、マスク層は、レーザー光の照射時にレーザー光の照射部の一部分が、状態1から光学的に異なる状態2へと変化することによって、レーザー光の波長を λ 、開口数をNAとすると、情報層に形成された $\lambda/(4 \times NA)$ よりも小さい記録ピットを読み出すことが可能であり、マスク層が状態2のとき、マスク層の表面或いは内部に異なる媒質が接する界面が存在し、この異なる媒質をそれぞれ媒質1、媒質2とし、媒質1の波長 λ における複素屈折率を $n_1 - ik_1$ 、媒質2の波長 λ における複素屈折率を $n_2 - ik_2$ とすると、 $(-5.0) \times n_2^2 \leq n_1^2 - k_1^2 \leq (-1.0) \times n_2^2$ の関係を満たす光学情報記録媒体を用い、波長 λ のレーザー光を用いて情報の記録再生を行うことを特徴とする。

【0021】本発明に係る光学情報記録媒体の記録再生方法は、基板上にマスク層と情報層とを少なくとも有する光学情報記録媒体を用いて情報の記録再生を行う方法であり、マスク層は、レーザー光の照射時にレーザー光の照射部の一部分が、状態1から光学的に異なる状態2

へと変化することによって、レーザー光の波長を λ 、開口数をNAとすると、情報層に形成された $\lambda/(4 \times NA)$ よりも小さい記録ピットを読み出すことが可能であり、マスク層が状態2のとき、マスク層の表面或いは内部に異なる媒質が接する界面が存在し、この異なる媒質をそれぞれ媒質1、媒質2とし、媒質1の波長 λ における複素屈折率を $n_1 - ik_1$ 、媒質2の波長 λ における複素屈折率を $n_2 - ik_2$ とすると、 $(-5.0) \times n_2^2 \leq n_1^2 - k_1^2 \leq (-1.0) \times n_2^2$ の関係を満たす光学情報記録媒体を用い、波長 λ のレーザー光を用いて情報の記録再生を行うことを特徴とする。

【0022】本発明に係る光学情報記録媒体の記録再生装置は、基板上にマスク層と情報層とを少なくとも有する光学情報記録媒体を用いて情報の記録再生を行う装置であり、マスク層は、レーザー光の照射時にレーザー光の照射部の一部分が、状態1から光学的に異なる状態2へと変化することによって、レーザー光の波長を λ 、開口数をNAとすると、情報層に形成された $\lambda/(4 \times NA)$ よりも小さい記録ピットを読み出すことが可能であり、かつマスク層が状態2のとき、マスク層の表面或いは内部に異なる媒質が接する界面が存在し、この界面において表面プラズモンが存在しうる条件とすることによって、情報信号の再生強度を向上させることを特徴とする。

【0023】

【発明の実施の形態】（実施の形態1）本発明の実施の形態を、以下に具体例を用いて説明する。本発明における光学情報記録媒体の層構成の一例を図1に示す。図1において、光透明層1及び基板7は、情報記録媒体を傷や酸化から保護する役割を担う保護材である。光透明層1及び基板7のうち、少なくとも記録再生に用いるレーザー光が通過しうる側は、レーザー光に対して透明な材料、或いは光吸収が生じても無視できる程度に小さい（例えば10%以下等）材料を使用する。なぜなら、用いるレーザー光の波長において基板で光吸収が生じる場合、レーザー光の光量を有効に活用することができず、記録再生時の信号振幅を大きくとる上で不利になるためである。図1においては、少なくとも光透明層1はレーザー入射側となりうるため、レーザー光に対して透明な材料、或いは光吸収が生じたとしても無視できる程度に小さい材料を用いる必要がある。

【0024】光透明層1及び基板7の材料の例としては、ポリカーボネート、ポリメチルメタクリレート、ポリオレフィン系樹脂、またはガラス等が挙げられる。光透明層1としては、成形等により所定の形状に作製した基板を用いてもよいし、シート状のものを所定の形状となるように加工したものを用いてもよい。或いは記録再生に用いるレーザー光に対して透明な紫外線硬化樹脂を用いてもよく、その膜厚がむらなく所定の膜厚範囲内となるように作製すればよい。ここでいう光透明層1とは、

後に述べる保護層 2 からみてレーザー入射側に作製されている透明な層全体を指すものとする。例えば、透明なシートを透明な紫外線硬化樹脂によって貼り合わせた場合、これらの全体を光透明層 1 と称することとする。光透明層 1、或いは基板 7 の少なくともいずれか一方には、レーザー光線を導くための案内溝が、情報層 5 側の表面に形成されていることが好ましい。

【0025】保護層 2、4、6 は、記録材料の保護と、情報層での効果的な光吸収を可能にするといった光学特性の調節とを主な目的として設けられる。保護層 2、4、6 の材料としては、ZnS 等の硫化物、ZnSe 等のセレン化物、Si-O、Al-O、Ti-O、Ta-O、Zr-O 等の酸化物、Ge-N、Cr-N、Si-N、Al-N、Nb-N、Mo-N、Ti-N、Zr-N、Ta-N 等の窒化物、Ge-O-N、Cr-O-N、Si-O-N、Al-O-N、Nb-O-N、Mo-O-N、Ti-O-N、Zr-O-N、Ta-O-N 等の窒酸化物、Ge-C、Cr-C、Si-C、Al-C、Ti-C、Zr-C、Ta-C 等の炭化物、Si-F、Al-F、Ca-F 等の弗化物、その他の誘電体、或いはこれらの適当な組み合わせ（例えば ZnS-SiO₂ 等）など、上記目的が達成可能な材料を用いる。

【0026】情報層 5 は、光学特性が異なる 2 つ以上の状態間をとりうる材料より構成する。この異なる光学状態を検出することによって、媒体の記録をなすのである。情報層 5 の材料は、この異なる状態間を可逆的に変化しうるものであってもよいし、非可逆的に変化しうるものであってもよい。可逆変化しうる材料の例としては、Sb、Te の少なくともいずれかを含む材料が挙げられる。この場合、光学特性差を大きくとることが容易に可能となるため好ましい。より具体的には、例えば Te-Sb-Ge、Te-Sb-Ge-N、Te-Sb-In、Te-Sb-In-Ag、Te-Sb-Sn-Ge、Te-Sb-Zn-Ge、Te-Sn-Sb、Te-Sb-Au-Ge、In-Sb-Se、In-Te-Se、Sb-Se、Bi-Se 等を主成分とする材料が挙げられる。1 回のみ書き込み可能な媒体をなすためには、非可逆変化する材料を用いてもよい。非可逆変化の材料例としては、Te-O、Te-O-Pd、Te-O-Au 等の Te-O を主成分とする材料や、Sb-O、Sn-O、Zn-O、Si-O、Ge-O を主成分とする材料が挙げられる。なかでも Te-O を主成分とする材料は、光学特性差を大きくとることが容易に可能となるため好ましい。

【0027】情報層 5 として可逆変化しうる材料を用いて書き換え可能な媒体を形成する場合、情報層 5 の膜厚は 3 nm 以上 20 nm 以下であることがより好ましい。膜厚が 3 nm 未満の場合、記録材料が層状になりにくく、良好な信号を得ることが困難となるためである。また膜厚が 20 nm より大きい場合は、情報層面内での熱

拡散が大きくなりやすいため、高密度での記録を行った際に既に書き込まれた隣接マークへ熱的な影響を及ぼす、いわゆる隣接消去の課題が生じ易くなってしまうためである。

【0028】マスク層 3 は、レーザー光の照射時にレーザー光の照射部の一部分のみが、状態 1 から光学的に異なる状態 2 へと変化しうる材料より成る。これにより、レーザー照射部のうちの状態 2 の部分のみ、或いは状態 1 の部分のみの情報を取り出すことが可能になり、本光学系の解像限界 $\lambda / (4 \times \text{NA})$ よりも小さい記録ピットを読み出すことが可能となる。ここで、 λ はレーザー光の波長、NA は開口数である。

【0029】マスク層 3 が状態 2 のとき、マスク層 3 の表面或いは内部に異なる媒質が接する界面が存在し、この異なる媒質をそれぞれ媒質 1、媒質 2 とし、レーザー光の波長における媒質 1 の複素屈折率を $n_1 - ik_1$ 、媒質 2 の複素屈折率を $n_2 - ik_2$ とするとき、 $(-5.0) \times n_2^2 \leq n_1^2 - k_1^2 \leq (-1.0) \times n_2^2$ の関係を満たすことにより信号を記録再生する際の光量を増加させることができ、信号強度を増強させることができることを本発明者らは発見した。これは、媒質 1 と媒質 2 がこの条件を満たす場合、媒質 1 と媒質 2 の界面において、表面プラズモンが強く励起されうするため、この界面での電磁場の強度を高めることができたためであると考えている。

【0030】図 2 を用いて、マスク層 3 にレーザーが照射された際の変化の例を説明する。図 2 は、図 1 で例示されるような媒体の層構成のうち、マスク層 3 の近傍のみを取り出して示しているものである。図 2 において、レーザー光照射部 10 のうち、8 で示す部分は初期状態と同じ状態 1 をとり、9 で示す部分は、あるしきい値以上のレーザーパワーが照射されたために状態 2 へと一時的に変化している部分である。レーザー光の通過後は、状態 2 は状態 1 へ変化し元の状態に戻る。状態 2 は、媒質 1 と媒質 2 とが混在する状態であり、媒質 1 と媒質 2 の界面において、レーザー光の波長における媒質 1 の複素屈折率を $n_1 - ik_1$ 、媒質 2 の複素屈折率を $n_2 - ik_2$ とするとき、 $(-5.0) \times n_2^2 \leq n_1^2 - k_1^2 \leq (-1.0) \times n_2^2$ の関係を満たすようにする。本発明においては、状態 2 の部分 9 に入射された光のうち、情報層 5 に到達する光量は、状態 1 の部分 8 に入射された光のうち、情報層 5 へ到達する光量に比べて大きくなる。これは、状態 2 において既に述べた条件を満たす界面が存在する場合、この界面において表面プラズモンが励起され、近接場光が増強されて発生しているためである。これにより、状態 2 の部分 9 に照射される光の強度を変調させることにより、本光学系の解像限界 $\lambda / (4 \times \text{NA})$ よりも小さいマーク 11 の形成が可能となる。このマーク 11 を再生、或いは消去する際も、同様にしてマスク層 3 に状態 2 の部分 9 を作り出すことによって、光学系の解像限界よりも小さいマークの再生、消去が可能となる。

【0031】図3に、マスク層3の変化の別の例を示す。図3において、12は状態1、13は状態2の部分である。ここでは13の部分を媒質1、保護層2及び保護層4を媒質2とし、この界面部分14において既述の $(-5.0) \times n_2^2 \leq n_1^2 - k_1^2 \leq (-1.0) \times n_2^2$ の関係を満たすようにする。このとき、媒質2をなすのは保護層2のみであってもよいし、保護層4のみであってもよいが、再生信号の増強効果をより大きく得るためには保護層2、4ともに上記の条件を満たすことが好ましい。このように、マスク層3と、保護層2及び/または保護層4との界面において、表面プラズモンの励起が増強される条件としても本発明の効果が得られる。

【0032】マスク層3の状態変化の例としては、例えば結晶状態からアモルファス状態への変化や、低酸化物、低窒化物、低弗化物等からより化学量論組成に近い組成への変化などが挙げられる。結晶状態からアモルファス状態への変化する材料の具体例としてはAuTe、CuTe、SnTe、NiCr、Cr、或いはこれらの混合物が挙げられる。これらの材料は、比較的広い波長範囲において本発明における $n^2 - k^2 \leq (-1.0) \times n_2^2$ の条件を満たしやすいため好ましい。低酸化物からより化学量論組成に近い組成へ変化する材料の例としては、Sn-O、In-O、Zn-O、或いはこれらの混合物等が挙げられる。これらの材料についても、本発明における $n^2 - k^2 \leq (-1.0) \times n_2^2$ の条件を満たしやすいため好ましい。マスク層3をなす材料の別の具体例として、Au、Ag、Cuのうち少なくともいずれかを含む材料が挙げられる。Au、Ag、Cuの材料はいずれも、ある波長における複素屈折率を $n - ik$ としたとき、 $n^2 - k^2 < 0$ の条件を満たしうる波長範囲が広く存在する。このため、これらの波長範囲においては本発明における $n^2 - k^2 \leq (-1.0) \times n_2^2$ の条件を満たしやすくなるため好ましい。例えば、Agは200nmから580nmといった赤色波長から青紫色波長までの広い波長範囲において、本発明での好ましい光学定数の条件を容易に満たすことができる。また、マスク層3の材料として、希土類元素が少なくとも1つ含まれることが好ましい。これにより、信号強度がさらに増強されやすくなる。

【0033】マスク層3が異なる2つの状態間を変化しうる温度は、情報層5が状態変化する温度を考慮して、最適な温度範囲内となるようにマスク層3及び情報層5の材料設計を行わなければならない。なぜならば、マスク層3の状態変化の温度が情報層5の状態変化の温度と比較してかなり高い場合、マスク層3が変化する際に情報層5へ熱的影響を及ぼしてしまい、既に書き込まれた信号が劣化してしまうといった課題が生じるためである。また、逆にマスク層3の状態変化の温度が低すぎると、常温で保存する際にマスク層3が経時変化してしまう、いわゆるシェルフ特性が劣化するという課題が生じ

てしまう。このため、マスク層3の状態変化温度を最適な範囲にしておく必要がある。具体的には、マスク層3の状態変化の温度は、130℃以上400℃以下であることが特に好ましい。400℃以下とするのは、情報層5の状態変化の温度が一般的に150℃から600℃程度の範囲内であることが多いことを考慮したものであり、130℃以上とするのは、シェルフ特性の劣化を防止するためである。マスク層3の材料として、状態変化温度が400℃以上の材料を用いることも可能であるが、この場合は情報層5の材料として、例えば600℃以上といった比較的高い温度で状態変化を起こしうる材料を用いることが好ましい。

【0034】本発明は、図1に示した構成に限定されるものではなく、マスク層3、及び情報層5を必須の層として、種々の構成に適用することが可能である。例えば、情報層5のいずれかの界面に別の層を新たに付加してもよく、保護層6を2層の保護層で形成してもよい。或いは、保護層2を2層の保護層で形成してもよいし、情報層5を2層以上の層で構成してもよい。本発明は、その他種々の構成に適用することが可能である。

【0035】次に、これらの光学情報記録媒体の製造装置について述べる。上記光学情報記録媒体を構成する多層膜を作製する方法としては、スパッタリング法、真空蒸着、CVD等の方法が可能である。ここでは一例として、スパッタリング法を用いて説明する。図4に成膜装置の一例の概略図を示す。

【0036】真空容器15には排気口21を通して真空ポンプ(図示省略)を接続しており、真空容器内を高真空に保つことができるようになっている。ガス供給口20からは、一定流量の希ガス、窒素、酸素、またはこれらの混合ガスを供給することができるようになっている。図中16は基板或いは光透明層であり、基板の自公転を行うための駆動装置17に取り付けられている。18はスパッタターゲットであり、陰極19に接続されている。陰極19は、図示は省略したが、スイッチを通して直流電源または高周波電源に接続されている。また、真空容器15を接地することにより、真空容器15と基板16は陽極に保たれている。

【0037】成膜ガスは希ガス、或いは場合に応じて希ガスに微量の窒素、或いは酸素等を混合したガスを用いる。希ガスとしては、Ar、Kr等の成膜可能なガスを用いよう。

【0038】情報層5や保護層2、4、6を作製する際、希ガスと微量の窒素、或いは微量の酸素との混合ガスを用いてもよい。これによって、作製した層の熱伝導率が低下することによる隣接消去の低減効果や、膜の強度が高まることによる繰り返し記録特性の向上等の効果を得ることが可能となる場合がある。

【0039】保護層2、4、6を構成する主成分として窒化物や酸化物、或いは窒酸化物を用いる場合、反応性

スパッタリング法によりスパッタを行うと良好な膜質の膜が得られる場合が多い。例えば、保護層としてSi-Nを用いる場合、Siを少なくとも含む材料をターゲットとし、成膜ガスとして希ガスと窒素との混合ガスを用いる。或いは希ガスと、N₂O、NO₂、NO、N₂等の窒素原子を含むガスとの混合ガス、或いは希ガスと上記の窒素原子を含むガスの適当な組み合わせで構成されるガスとの混合ガスを用いてもよい。

【0040】書き換え可能な媒体をなすために相変化形記録材料を用いる場合、媒体を製造した後、或いは製造工程の途中で、情報層5を結晶状態に変化させるため、強いレーザー光の照射等のエネルギー照射工程を経ることが一般的である。これにより、情報記録の書き換えが初回から容易に可能となる。但し本発明においては、この結晶化工程を省略するために、情報層5を成膜した直後の状態が結晶状態となるように、情報層5を結晶化しやすい材料とするか、或いは情報層5を成膜する工程の前に、結晶化成膜が可能な記録材料を薄く成膜した後に情報層5を成膜する等の方法をとることが好ましい。例えば、情報層5の主成分としてSb或いはTeを含む材料を用いる場合、情報層5を成膜する直前にSb、Sn、Te等の成膜直後が結晶状態になりうる材料の層を作製し、その上に情報層5を成膜することにより、情報層を成膜直後で結晶状態とすることができる。或いは、Sb、Sn、Te等を多く含む材料を情報層5の材料として用いることにより、情報層5を成膜した直後の状態を結晶状態とすることができる。これにより、情報層5を結晶化させる工程を省略することができコスト削減が可能となるばかりでなく、結晶化工程を経ることによってマスク層3に余計な熱ダメージを与えることがなくなるため、特に本発明においては採用することが好ましい。

【0041】次に、以上のようにして形成した光学情報記録媒体の記録再生方法の一例について述べる。図5に、光学情報記録媒体が光ディスクである場合に、記録再生に用いる装置の一例の概略を示す。信号の記録再生、消去には、レーザー光源22と、対物レンズ23を搭載した光ヘッドと、レーザー光を照射する位置を所定の位置へと導くための駆動装置24、トラック方向及び膜面に垂直な方向の位置を制御するためのトラッキング制御装置及びフォーカシング制御装置（図示省略）と、レーザーパワーを変調するためのレーザー駆動装置（図示省略）、媒体を回転させるための回転制御装置25とを用いる。

【0042】信号の記録、消去、再生は、まず媒体を回転制御装置25を用いて回転させ、光学系によりレーザー光を微小スポットに絞こんで、媒体へレーザー光を照射することにより行う。このとき、既に述べたメカニズムによって、解像限界 $\lambda/(4 \times NA)$ より小さいマークを記録、消去することが可能となる。

【0043】信号の再生の際には、信号の記録、或いは

消去を行うパワーレベルよりも低く、そのパワーレベルでのレーザー照射によって記録マークの光学的な状態が影響を受けず、かつその照射によって媒体から記録マークの再生のために十分な光量が得られるパワーのレーザービームを照射し、得られる媒体からの信号を検出器で読みとることによって行う。

【0044】情報の記録再生を行うレーザー光の波長 λ は、先述のマスク層3が媒質1であるときの波長 λ における複素屈折率を $n_1 - ik_1$ 、媒質2であるときの波長 λ における複素屈折率を $n_2 - ik_2$ とすると、 $(-5.0) \times n_2^2 \leq n_1^2 - k_1^2 \leq (-1.0) \times n_2^2$ の関係を満たしうる範囲内とする。これにより、情報信号を記録再生する際の光量を増加させることができ、信号強度を増強させることができる。マスク層3がAgを含むときは、レーザー光の波長を200nm以上580nm以下の範囲内とすることが好ましい。特に200nm以上450nm以下とすることがさらに好ましい。この条件を用いることにより、表面プラズモンの発生強度を最も強くすることが可能となり、信号の記録、或いは再生いずれの場合でも信号強度を高めることが可能となる。400nm付近の波長を有するレーザーとしては、近年開発が進んでいるGaN系の半導体レーザーや、SHGレーザーの技術を用いたレーザーを用いることができる。

【0045】マスク層3がAuTe、CuTe、SnTe、NiCr、Crのうち少なくともいずれかを含むときは、レーザー光の波長を200nm以上580nm以下とすることが特に好ましい。この条件を用いることにより、表面プラズモンの発生強度を最も強くすることが可能となり、信号の記録、或いは再生いずれの場合でも信号強度を高めることが可能となる。

【0046】マスク層3がSn-O、In-O、Zn-Oのうち少なくともいずれかを含むときは、レーザー光の波長を200nm以上580nm以下とすることが特に好ましい。この条件を用いることにより、表面プラズモンの発生強度を最も強くすることが可能となり、信号の記録、或いは再生いずれの場合でも信号強度を高めることが可能となる。

【0047】信号を再生する際は、必要に応じてアパランシェフォトダイオード（APD）を用いることが好ましい。APDを用いた場合、微小信号のゲインを高めて大きい信号強度を容易に得ることができるため、本発明の再生信号増強効果をさらに顕著に得ることができる。

【0048】

【実施例】次に、具体的な実施例をもって本発明をさらに詳細に述べる。

【0049】（実施例1）一例として図1の構成において、光透明層1、基板7とともに厚さ0.6mm、直径120mmのディスク状ポリカーボネート樹脂、保護層2、4とともにSiC、保護層6をZnSにSiO₂を20mol%混合した材料、情報層5をGe₃₀Sb₁₅T

e55、マスク層3をSnTeとした媒体を作製した。これを媒体(1)とする。各層の膜厚はともに、保護層2、4、6をそれぞれ130nm、20nm、40nm、情報層5を15nm、マスク層3を20nmとした。レーザー光の案内溝は光透明層1に形成し、溝深さを42nm、トラックピッチを0.36μmとした。

【0050】情報層5を成膜する際は、Arガスを全圧が0.13Paとなるように供給し、陰極にDC1.27W/cm²のパワーを投入して行った。保護層2、4、6を成膜する際には、Arガスを全圧が0.13Paとなるように供給し、陰極にRF5.10W/cm²のパワーを投入して行った。マスク層5を成膜する際は、Arガスを全圧0.26Paになるように供給し、DC4.45W/cm²のパワーを投入して行った。

【0051】信号の記録再生を行う際は、波長400nm、対物レンズの開口数が0.60のレーザー光を用い、ディスク回転速度を線速3.0m/sとした。ディスクの特性評価は、マーク長0.12μmの単一信号を適正なレーザーパワーで溝部に記録し、このC/Nを測定することにより行った。

【0052】別の実施例として、レーザー光の案内溝の深さを67nm、トラックピッチを0.60μmとした以外は媒体(1)と全く同じ膜厚構成を有するディスクを作製し、これを媒体(2)とする。媒体(2)のディスク特性の評価は、記録再生のレーザー波長を650nm、マーク長を0.20μmとした以外は媒体(1)と全く同様の条件で行った。

【0053】これらの実施例においてマスク層SnTeは、あるしきい値以上のレーザーパワーが照射された場合に結晶状態から熔融状態に変化し得、レーザーが通過した後は再び結晶状態に戻りうる。SnTe、及びSiCの波長400nmにおける光学定数は、それぞれ1.8-*

*i3.4、3.4-i0.4、波長650nmにおける光学定数は、それぞれ3.8-i5.0、3.3-i0.1であった。このときSnTeを媒質1、保護層2及び保護層4をなすSiCを媒質2とし、媒質1、2の光学定数をそれぞれ n_1-ik_1 、 n_2-ik_2 とすると、

波長400nmにおいては、 $(-5.0) \times n_2 = -17.0$ 、 $n_1^2 - k_1^2 = -8.3$ 、 $(-1.0) \times n_2 = -3.4$ 、

波長650nmにおいては、 $(-5.0) \times n_2 = -16.5$ 、 $n_1^2 - k_1^2 = -10.6$ 、 $(-1.0) \times n_2 = -3.3$

であり、いずれの波長についても、 $(-5.0) \times n_2^2 \leq n_1^2 - k_1^2 \leq (-1.0) \times n_2^2$ の関係を満たしている。

【0054】比較例として、マスク層3をSbとし、保護層2、4をZnS-SiO₂とした以外は全て媒体(1)、及び媒体(2)と同様とした媒体を作製した。これらの媒体をそれぞれ媒体(100)、(101)とする。媒体(100)、(101)についても、それぞれ媒体(1)、(2)と同様の評価を行った。

【0055】このとき、Sb及びZnS-SiO₂の波長400nmにおける光学定数は、それぞれ1.5-i3.7、

2.2-i0.0、波長650nmにおける光学定数は、4.8-i5.0、2.1-i0.0であった。Sbを媒質1、保護層2及び保護層4をなすZnS-SiO₂を媒質2とし、媒質1、2の光学定数をそれぞれ n_1-ik_1 、 n_2-ik_2 とすると、

波長400nmにおいては、 $(-5.0) \times n_2 = -11.0$ 、 $n_1^2 - k_1^2 = -11.4$ 、 $(-1.0) \times n_2 = -2.2$ 、波長650nmにおいては、 $(-5.0) \times n_2 = -10.5$ 、 $n_1^2 - k_1^2 = -2.0$ 、 $(-1.0) \times n_2 = -2.1$ 、であり、この比較例においては $(-5.0) \times n_2^2 \leq n_1^2 - k_1^2 \leq (-1.0) \times n_2^2$ の関係を満たさない。

(表1)に、以上の全ての媒体を評価した結果を示す。

【0056】

【表1】

マスク層	媒体番号	C/N $\lambda = 400\text{nm}$	媒体番号	C/N $\lambda = 650\text{nm}$
Sb	(100)	×	(101)	×
SnTe	(1)	○	(2)	○

【0057】ここで、C/Nについては、20dB以上得られた場合を○、20dB未満であったものを×として示した。(表1)によると、媒体(1)及び媒体

(2)では比較例となるそれぞれ媒体(100)、媒体(101)に比べてC/Nが改善されている。これは、媒体(1)及び(2)ではマスク層付近で表面プラズモンが励起される条件となっているため、信号強度が増強されたが、媒体(100)、媒体(101)ではこのメカニズムが働かないためであると考えている。

【0058】なお、媒体(1)(2)において、マスク層3としてAuTe、CuTeを用いた場合も、上記と同様の効果が得られた。

【0059】以上より、マスク層3の界面において表面プラズモンが強く励起されうる条件となるように媒体を構成することによって、解像限界より小さい信号を記録再生する際であっても、信号強度を増強することが可能となることわかる。

【0060】

【発明の効果】本発明に係る光学情報記録媒体は、基板上にマスク層と情報層とを少なくとも有し、マスク層は、レーザー光の照射時にレーザー光の照射部の一部分が、状態1から光学的に異なる状態2へと変化することによって、前記レーザー光の波長を λ 、開口数をNAとすると、情報層に形成された $\lambda/(4 \times NA)$ よりも小

さい記録ビットを読み出すことが可能であり、マスク層が状態2のとき、マスク層の表面或いは内部に異なる媒質1、及び媒質2が接する界面が存在し、レーザー光の波長における媒質1の複素屈折率を $n_1 - ik_1$ 、媒質2の複素屈折率を $n_2 - ik_2$ とすると、 $(-5.0) \times n_2^2 \leq n_1^2 - k_1^2 \leq (-1.0) \times n_2^2$ の関係を満たすので、これにより、光学系の解像限界より小さい信号を記録再生する際であっても、信号強度が飛躍的に向上した光学情報記録媒体を得ることが可能になる。従って超解像記録を行った場合であっても大きい信号変調度と十分大きい再生信号を得ることが可能となり、さらなる高密度記録が可能な記録媒体を提供することができる。

【0061】本発明に係る光学情報記録媒体は、マスク層はAu、Ag、或いはCuのうち少なくとも1元素を含むので、上記の媒質1、媒質2が $(-5.0) \times n_2^2 \leq n_1^2 - k_1^2 \leq (-1.0) \times n_2^2$ の関係を容易に満たすことが可能となる。

【0062】本発明に係る光学情報記録媒体は、マスク層がAgを含み、かつ情報の読み出しに用いるレーザー光の波長を200nmから580nmの範囲内とするので、媒質1、媒質2が $(-5.0) \times n_2^2 \leq n_1^2 - k_1^2 \leq (-1.0) \times n_2^2$ の関係を容易に満たすことができるばかりでなく、信号強度の増強をより顕著に得ることが可能となる。

【0063】本発明に係る光学情報記録媒体は、マスク層がAuTe、CuTe、SnTe、NiCr、Crのうち少なくともいずれか1つを含むので、上記の媒質1、媒質2が $(-5.0) \times n_2^2 \leq n_1^2 - k_1^2 \leq (-1.0) \times n_2^2$ の関係を容易に満たすことが可能となる。

【0064】本発明に係る光学情報記録媒体は、マスク層がSn-O、In-O、Zn-Oのうち少なくともいずれか1つを含むので、上記の媒質1、媒質2が $(-5.0) \times n_2^2 \leq n_1^2 - k_1^2 \leq (-1.0) \times n_2^2$ の関係を容易に満たすことが可能となる。

【0065】本発明に係る光学情報記録媒体は、マスク層は少なくとも1種類の希土類を含むので、信号強度がさらに増強されやすくなる。

【0066】本発明に係る光学情報記録媒体は、マスク層が異なる2つの状態を変化しうる転移温度が130℃以上400℃以下であるので、既に書き込まれた信号を再生する際の再生光劣化を低減することが容易に可能となる。

【0067】本発明に係る光学情報記録媒体は、情報層が2つ以上の光学的に異なる状態間を変化しうる材料よりなるので、情報の記録、或いは書き換えが可能となるため、ユーザー情報の書き込みが可能である高密度記録媒体を提供することができる。

【0068】本発明に係る光学情報記録媒体は、情報層が結晶状態とアモルファス状態とを可逆的に変化しうる材料よりなるので、大きい信号強度を得ることが容易に

可能となる。

【0069】本発明に係る光学情報記録媒体は、情報層が作製直後で結晶状態であるので、情報層を結晶化させる工程を省略することができコスト削減が可能となるばかりでなく、結晶化工程を経ることによってマスク層に余計な熱ダメージを与えることがないため、記録再生前の媒体の劣化を防ぐことが容易に可能となる。

【0070】本発明に係る光学情報記録媒体は、情報層がSb、Te、Seのうち少なくともいずれか1つを含む相変化材料であるので、大きい信号強度を得ることがより容易に可能となる。

【0071】本発明に係る光学情報記録媒体は、情報層が1回のみの書き込みが可能である材料よりなるので、簡単な層構成を採用することができるため、コスト削減が可能となるばかりでなく、媒体を作製する際の歩留まりを高く保つことが容易に可能となる。

【0072】本発明に係る光学情報記録媒体は、情報層がTeとOとを少なくとも含む材料よりなるので、1回のみの書き込みが可能な媒体において、大きい信号強度を容易に得ることが可能となる。

【0073】本発明に係る光学情報記録媒体の記録再生装置は、基板上にマスク層と情報層とを少なくとも有する光学情報記録媒体を用いて情報の記録再生を行う装置であり、マスク層は、レーザー光の照射時にレーザー光の照射部の一部分が、状態1から光学的に異なる状態2へと変化することによって、レーザー光の波長を λ 、開口数をNAとすると、情報層に形成された $\lambda / (4 \times NA)$ よりも小さい記録ビットを読み出すことが可能であり、マスク層が状態2のとき、マスク層の表面或いは内部に異なる媒質が接する界面が存在し、この異なる媒質をそれぞれ媒質1、媒質2とし、媒質1の波長 λ における複素屈折率を $n_1 - ik_1$ 、媒質2の波長 λ における複素屈折率を $n_2 - ik_2$ とすると、 $(-5.0) \times n_2^2 \leq n_1^2 - k_1^2 \leq (-1.0) \times n_2^2$ の関係を満たす光学情報記録媒体を用い、波長 λ のレーザー光を用いて情報の記録再生を行うことを特徴とする。

【0074】これにより、レーザー光のスポット径より小さい信号を記録再生する際であっても、信号強度が飛躍的に向上した光学情報記録媒体の記録再生装置を得ることが可能になる。従って超解像記録を行った場合であっても大きい信号変調度と十分大きい再生信号を得ることが可能となり、さらなる高密度記録が可能な記録再生装置を提供することができる。

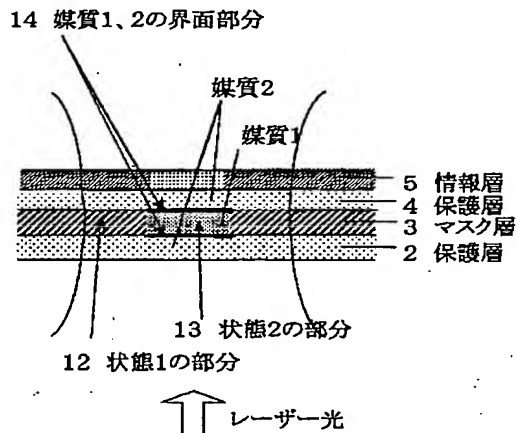
【0075】本発明に係る光学情報記録媒体の記録再生方法は、基板上にマスク層と情報層とを少なくとも有する光学情報記録媒体を用いて情報の記録再生を行う方法であり、マスク層は、レーザー光の照射時にレーザー光の照射部の一部分が、状態1から光学的に異なる状態2へと変化することによって、レーザー光の波長を λ 、開口数をNAとすると、情報層に形成された $\lambda / (4 \times NA)$

A) よりも小さい記録ビットを読み出すことが可能であり、マスク層が状態2のとき、マスク層の表面或いは内部に異なる媒質が接する界面が存在し、この異なる媒質をそれぞれ媒質1、媒質2とし、媒質1の波長 λ における複素屈折率を $n_1 - ik_1$ 、媒質2の波長 λ における複素屈折率を $n_2 - ik_2$ とすると、 $(-5.0) \times n_2^2 \leq n_1^2 - k_1^2 \leq (-1.0) \times n_2^2$ の関係を満たす光学情報記録媒体を用い、波長 λ のレーザー光を用いて情報の記録再生を行うので、レーザー光のスポット径より小さい信号を記録再生する際であっても、信号強度が飛躍的に向上した光学情報記録媒体の記録再生方法を得ることが可能になる。従って超解像記録を行った場合であっても大きい信号変調度と十分大きい再生信号を得ることが可能となり、さらなる高密度記録が可能な記録再生方法を提供することができる。

【0076】本発明に係る光学情報記録媒体の記録再生装置は、基板上にマスク層と情報層とを少なくとも有する光学情報記録媒体を用いて情報の記録再生を行う装置であり、マスク層は、レーザー光の照射時にレーザー光の照射部の一部分が、状態1から光学的に異なる状態2へと変化するることによって、レーザー光の波長を λ 、開口数をNAとすると、情報層に形成された $\lambda / (4 \times NA)$ よりも小さい記録ビットを読み出すことが可能であり、かつマスク層が状態2のとき、マスク層の表面或いは内部に異なる媒質が接する界面が存在し、この界面において表面プラズモンが存在しうる条件とすることによって、情報信号の再生強度を向上させるので、レーザー光のスポット径より小さい信号を記録再生する際であっても、信号強度が飛躍的に向上した光学情報記録媒体の記録再生装置を得ることが可能になる。従って超解像記録を行った場合であっても大きい信号変調度と十分大きい再生信号を得ることが可能となり、さらなる高密度記録が可能な記録再生装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図3】



【図1】本発明における層構成の一例を示す図

【図2】本発明におけるマスク層の状態変化の一例を示す図

【図3】本発明におけるマスク層の状態変化の一例を示す図

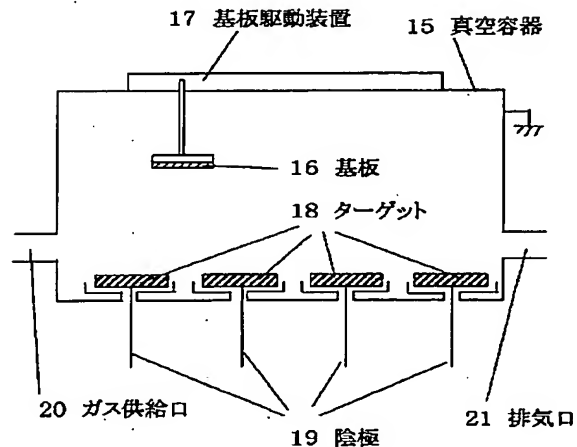
【図4】成膜装置の一例を示す図

【図5】記録再生装置の一例を示す図

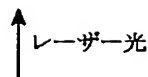
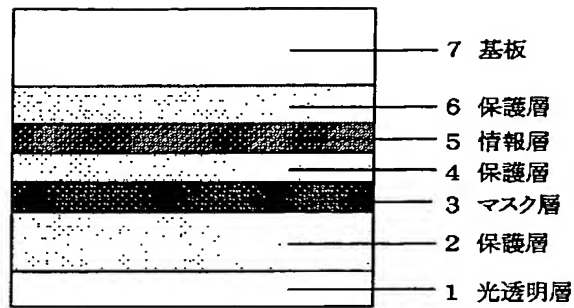
【符号の説明】

- 1 光透明層
- 2 保護層
- 3 マスク層
- 4 保護層
- 5 情報層
- 6 保護層
- 7 基板
- 8 状態1の部分
- 9 状態2の部分
- 10 レーザー光照射部分
- 11 マーク
- 12 状態1の部分
- 13 状態2の部分
- 14 媒質1と媒質2の界面部分
- 15 真空容器
- 16 基板
- 17 基板駆動装置
- 18 ターゲット
- 19 陰極
- 20 ガス供給口
- 21 排気口
- 22 レーザー光源
- 23 対物レンズ
- 24 駆動装置
- 25 回転制御装置

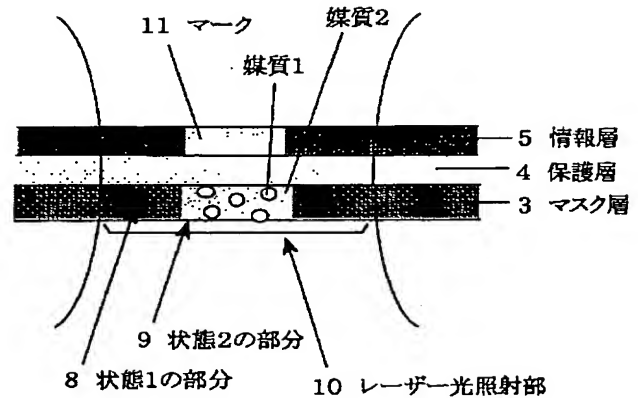
【図4】



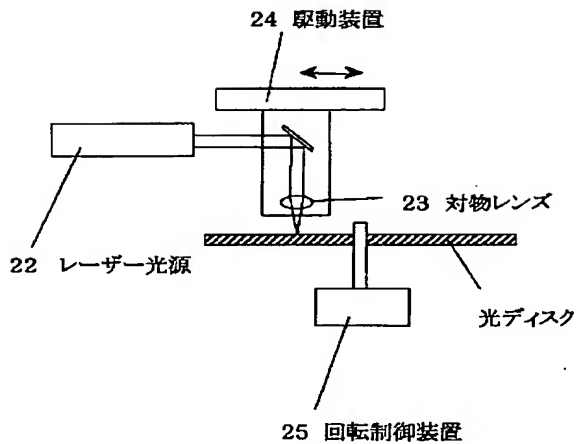
【図1】



【図2】



【図5】



BEST AVAILABLE COPY

フロントページの続き

(72)発明者 山本 博昭
 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
 産業株式会社内

Fターム(参考) 5D029 LA13 LB01 LC05 MA39
 5D090 AA01 CC01 CC04 DD02 EE02
 FF11